





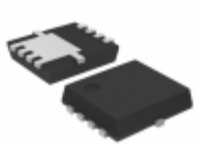
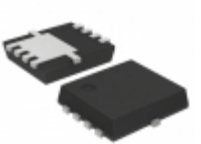

	<h2>RQ3E100BNTB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RQ3E100BNTB</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 10A HSMT8</p> <p>Datenblätter:  RQ3E100BNTB.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RQ3E100BNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A HSMT8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.4 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

RQ3E100BNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3E100BNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3E100BNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3E100BNTB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RQ3E100BNFU7 ROHM/ RQ3E100BNFU7 ROHM/</p>	 <p>RQ3E100GN QQ2850920316 RQ3E100GN QQ2850920316</p>	 <p>RQ3E100BNFU7TB ROHM RQ3E100BNFU7TB ROHM</p>	 <p>RQ3E100BSFU7TB ROHM ROHM QFN</p>
 <p>RQ3E100BN QQ2850920316 RQ3E100BN QQ2850920316</p>	 <p>RQ3E100GNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A 8-HSMT</p>	 <p>RQ3E080GNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8-HSMT</p>	 <p>RQ3E100GNFU7TB ROHM RQ3E100GNFU7TB ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RQ3E100BNTB LAPIS Semiconductor	RQ3E100BNTB Datenblatt	RQ3E100BNTB-Datenblätter	RQ3E100BNTB PDF	LAPIS Semiconductor RQ3E100BNTB
RQ3E100BNTB Electronic	RQ3E100BNTB-Komponenten	RQ3E100BNTB-Verteiler	RQ3E100BNTB-Bild	RQ3E100BNTB-Teil
RQ3E100BNTB Preis	RQ3E100BNTB Hersteller	RQ3E100BNTB Bild	RQ3E100BNTB Aktie	RQ3E100BNTB Inventar
RQ3E100BNTB Neu	RQ3E100BNTB Original	RQ3E100BNTB garantiert	RQ3E100BNTB RFQ	RQ3E100BNTB Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited